

頁	行・図	誤	正
2	図1.1中	水溶液中のイオン H ⁺ , SO ₄ ²⁻ , OH ⁻ 影響小 ⇒ 無視	水溶液中のイオン H ⁺ , SO ₄ ²⁻ , OH ⁻ 影響小 ⇒ 無視
5	上から2行目	反応式で表すことが多い。	反応式で表せる。
13	上から2行目	, といった点であろう。	, である。
29	下から2行目	の中で満たされた状態で存在している。	を満たしている。
34	式(3.3)	$gG(\nu, T)$	$qG(\nu, T)$
46	下から1行目	の温度, q は電子の電荷である。	の温度である。
48	式(4.20)	$F_s - F_c(V) + R(0) - R(V)$	$F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)$
	式(4.21)	$= F_s - F_c(V) + R(0) - R(V)$ $\leftrightarrow I = q\{F_s - F_{c0} + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)\}$ $\leftrightarrow I = q\left\{F_s - F_{c0} + F_{c0} - F_{c0} \exp\left(\frac{V}{V_c}\right) + R(0) - R(0) \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = q(F_s - F_{c0}) + q\{F_{c0} + R(0)\}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = q(F_s - F_{c0}) + \frac{qF_{c0}}{f_c}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$	$= F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)$ $\leftrightarrow I = q\{F_s + F_{c0} - F_c(V) + R(0) - R(V)\}$ $\leftrightarrow I = q\left\{F_s + F_{c0} - F_{c0} \exp\left(\frac{V}{V_c}\right) + R(0) - R(0) \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = qF_s + q\{F_{c0} + R(0)\}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$ $\leftrightarrow I = qF_s + \frac{qF_{c0}}{f_c}\left\{1 - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$
	下から9行目	無輻射において	非輻射において
	上から7行目	F_c	f_c
50	上から8行目	$q(F_s - F_{c0})$	qF_s
	下から1行目	輻射と非輻射の両方による電子 - 正孔対の再結合が増加することとなり,	(削除)
51	上から9行目	$q(F_s - F_{c0})$	qF_s
	上から10行目	第1項の太陽光エネルギーによって生成された電子-正孔対の数 F_s は, 太陽電池自体の温度 T_c での黒体輻射による電子-正孔対の生成数 F_{c0} よりはるかに大きい, すなわち, $F_s \gg F_{c0}$ なので $q(F_s - F_{c0}) \doteq qF_s$ (4.26) と表される。	(削除)
	下から7行目	式(4.26)の近似を用いたうえで,	(削除)
52	上から12行目	無輻射 (2箇所)	非輻射 (2箇所)
58	式(4.29)'	$\exp\left(\frac{V_{op}}{V}\right)$	$\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right)$
59	式(5.7), 式(5.8)	$\left\{\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right) - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$	$\left\{\exp\left(\frac{V_{op}}{V_c}\right) - \exp\left(\frac{V}{V_c}\right)\right\}$
77	下から1行目	InGaP/InGaAs/Ge	InGaP/GaAs/InGaAs
115	上から10行目	波長の光が	波長 λ の光が
119	上から6行目	(N層膜厚)	(n層膜厚)
120	上から9行目	電子流密度	電流密度
130	図8.2		
141	脚注の下から1行目	エネルギー分散については	エネルギー分散については
147	下から1行目	$1.15m_0$	$0.54m_0$
148	式(8.29)	$= \sqrt{(2.86 \times 10^{19})(3.01 \times 10^{19})} \exp\left(-\frac{1.124}{2 \times 0.02586}\right)$ $= 1.08 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$	$= \sqrt{(2.89 \times 10^{19})(1.01 \times 10^{19})} \exp\left(-\frac{1.124}{2 \times 0.02586}\right)$ $= 6.23 \times 10^9 \text{ cm}^{-3}$
149	下から3行目	$n_0 \doteq 1.2 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$	$n_0 \doteq 3.9 \times 10^4 \text{ cm}^{-3}$
	下から2行目	0.21 eV (2箇所)	0.18 eV (2箇所)
150	上から8行目	このように半導体が	半導体が
151	上から6行目	n_i の曲線は真性半導体における電子密度の	曲線は真性半導体における電子密度 n_i の
	図8.13図説	N型Si	n型Si

頁	行・図	誤	正
154	下から13行目	いずれの場合も電子の有効質量のほうが正孔の有効質量より小さいので、電子の移動度のほうが大きくなる。	いずれの場合も電子の移動度のほうが大きい。
155	式(8.47)	$\doteq e \frac{l}{2t} \cdot \frac{dn}{dx}$	$\doteq e \frac{l}{2t} \cdot \frac{dn}{dx} l$
156	式(8.49), (8.50)	$\frac{kT}{q}$	$\frac{kT}{e}$
157	上から5行目	連続の方程式	連続の方程式
160	上から12行目	非平衡化での	非平衡下での
165	式(8.76)	$= \left[E_g - kT \left(\ln \frac{N_C}{N_D} + \ln \frac{N_V}{N_A} \right) \right]$	$= E_g - kT \left(\ln \frac{N_C}{N_D} + \ln \frac{N_V}{N_A} \right)$
166	式(8.81)	$-\frac{qN_D}{2\epsilon} \quad x_N \leq x \leq x_0$	$-\frac{eN_D}{2\epsilon} \quad x_N \leq x \leq x_j$
	式(8.82)	$x_0 \leq x \leq x_P$	$x_j \leq x \leq x_P$
169	上から9行目	$\Delta n_N(x_N)$	$\Delta p_N(x_N)$
177	索引	連続の方程式 116	連続の方程式 116, 157

最新の正誤表がコロナ社ホームページにある場合がございます。

①

下記URLにアクセスして[キーワード検索]に書名を入力して下さい。

<http://www.coronasha.co.jp>